非镜象张氏电极的设计和加工程序

徐春生

摘要:本文在张氏电极理论及其设计程序的基础上,提出了非镜象张氏电极的 概念及其设计理论和设计程序。本文还介绍了张氏电极的数控加工程序。

The procedure for non-symmetry Chang-electrode design and production

Xu Chunsheng

(Hefei Daily use Chemical General Factory)

Abstract: Based on the Chang-electrode theory and its procedure designing, the concept, design theory and procedure about the non-symmetry Chang-electrode are described. The process of the Chang-electrode with numerically-controlled machinery.

准分子激光器和其它种类的激光器中,主放电电极的截面要求有适当的形状,使得电极 范围内的电场强度分布均匀,电极边缘附近的电场强度低于电极范围内的电场强度,这样才 能保证大体积范围内的均匀放电。

现在,已有很多种能近似满足上面要求的电极剖面,其中以Rogowski电极和张氏电极 最为常见。

Rogowski电极的剖面方程为[1]:

$$y = \frac{a}{\pi} \exp\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{a}{2} \tag{1}$$

实际设计中用光滑连接的直线、正弦曲线和圆弧线来代替(1)所给的曲线,这样的电极 具有加工简单性和一定的有效性。

1973年,张提出了一簇由双曲函数线构成的分析剖面[²],这种电极剖面在平滑性、紧致 性、均匀性等方面都优于Rogowski电极。

一、张氏电极设计理论和镜象电极设计[2'3]

张氏电极剖面簇源于下列的保角变换:

$$z = \omega + k \mathrm{sh} \ \omega \tag{2}$$

式中, z = x + iy, $\omega = u + iv$, x, y是空间坐标, u, v是电通量和电位函数, 且k > 0。对于每 一个v值($|v| < \pi$)对应的等电位剖面为:

$$x = u + k \cos v \sin u \tag{3}$$

(4)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

"是参变量。注意:每个等势面都是#轴对称的。而且共轭等位面v和-v所对应的两个面是x轴 **对称的。因此,我们只需**研究v为正值且限干第一象限就足够了。

 $u = v + k \sin v c h u$

由电动力学可给出下列的电场表达式:

$$E^{-2} = |dz/d\omega|^2 = (1 + k\cos v chu)^2 + (k\sin v shu)^2$$
(5)

可将其展开成u的级数形式如下。

$$E = a_0(v) + a_2(v)u^2 + a_4(v)u^4 + \dots$$
(6)

奇数项因考虑对称性而消失。为在电极中央(u=0)附近获得最大平坦电场分布, 要求 $a_1(v) = 0$, 即 $\partial^2 E^{-2}/\partial^2 u |_{u=0} = 0$, 由此可导出:

$$= \arccos(-k) = \pi/2 + \arcsin(-k)$$
(7)

设у₀为电极中央的点, *x_m、y_m、u_m* 分别为电极边缘的*x、y、u* 的值, 由(3)、(4)、(7) 式可 得.

$$x_n/y_0 = (u_m - k^2 \operatorname{sh} u_m)/\operatorname{arc\ cos\ } (-k) + k\sqrt{1 - k^2}$$
(8)

一般取电极厚度为电极间距的1/4, 即 $y_m = 3y_0/2$, 则有:

 $chu_m = \arccos(-k)/2k\sqrt{1-k^2} + 3/2$

由(8)、(9)式即可确定电极纵横比x_m/y₀和k的关系,在给定纵横比的情况下,求出 电极方程中的参量k再由(7)式求出相应的v即可得电极剖面方程

上述计算需要使用迭代法。

二、非镭象张氏电极的设计

如图1所示的等v曲线簇,镜象电极为选取 $v = v_1 \pi v = -v_1$ 作为上下剖面的 电 极,非镜象 **电极则为选取υ**=υ₁和υ=-υ₂(υ₁≠υ₂)作为上下剖面的电极。



$$\delta_m = (E(0) - E(u_m)]/E(0) \qquad (14)$$

由∂_m的×轴分布情况我们就可以了解电极的放电性能,以便使我们能选取出—对满意的 电极来。

实际的电极方程应是张氏理论方程乘上一个比例因子。即:

 $x_i = au + ak\cos v_i shu$

(i = 1, 2)

(16) $y_i = av_i + ak \sin v_i chu$ わしいけい し声め 七田河復

$$将_{X_{m_1}}, y_{m_1} - y_{01}, x_{m_2}, y_{m_2} - y_{02}$$
和 h 的值代入上面的方程可得,

$$\alpha_{m1} = \alpha u_{m1} + \alpha k \cos v_1 \sin u_{m1} \tag{17}$$

$$y_{m_1} - y_{01} = \alpha k \sin v_1 c n u_{m_1} - \alpha k \sin v_1$$
(18)

(19) $x_{m_2} = \alpha u_{m_2} + \alpha k \cos v_2 \sinh u_{m_2}$

$$y_{m_2} - y_{02} = \alpha k \sin v_2 c h u_{m_2} - \alpha k \sin v_2$$
(20)

$$h = y_{01} + y_{02} = av_1 + aks_{1}nv_1 + av_2 + aks_{1}nv_2$$
(21)

因为窄电极(即下电极)的表面基本上都处于有效放电区域内,需用张氏理论中的最大 平坦场条件即(7)式来约束k值,即。

$$k = -\cos v$$

(22)

方程组(17)~(22)式共6个方程,6个未知 数(a,k,v1,v2, u_{m1}, u_{m2}), 理论 上是可解的,实际的运算中,我们采用迭代法处理,具体步骤如下:

- (1) 给定v1、v2的初始值代入(22) 式求出k值。
- (2) 将k、v1、v2代入(21) 式求出a值。
- (3) 将a、k、v1、v2代入(18) 和(20) 式求出um1、um2的值。
- (4) 由a、k、um1、um2通过(17) 和(19) 式求出新的v1和v2值。



(5) 将新的v1、v2值作为初始值, 重复上 面的计算直至相邻的两次v1、v2值的差 ⊿v1、 ⊿v₂达到我们所满意的精度要求。

上述迭代可使用微机处理。我们采用PC-1500袖珍电子计算机编制了一套设计程序[4], 其框图可参见图2。

利用此程序也可以设计镜象张氏电极,只 要令输入语句中 $x_{m_1} = x_{m_2}$, $y_{m_1} - y_{0_1} = y_{m_2} - y_{m_2}$ **u**₀,即可。

本程序采用人机对话的方式,具有操作简 单、功能齐全、运转迅速等优点。它不仅能准 确地给出理论电极的形状和参数,还为我们进 行经验模拟提供了极大的方便。

根据电场均匀度分布的情况并参照西德进 口101型准分子激光器的放电电极设计,我们给 出的电极尺 寸 为 (xm1, ym1-y01, xm2, ym2 $-y_{02}$, h) = (15.5, 10, 27, 6, 24)。 代入 所编程序,由此可计算出理论电极的参数为: $k = 2.86923 \times 10^{-1}, v_1 = 1.86182,$ $v_2 = 7.01435 \times 10^{-1}, \ \alpha = 7.93843_{\circ}$

(15)

1103

....

(24)

三、张氏电极的数控加工程序

对于给定解析方程的复杂曲面的精加工,比较有效的方法是使用带微机控制的数控机床。 目前,我们采用的数控机床型号为UB-75,其操作语言系统为Fanuc-6MB,使用其宏指令编 制用户宏程序[⁶],通过键盘输入系统,即可完成所要求的精加工。

张氏电极的剖面方程可简化为:

y

$$x = au + b \operatorname{sh} u \tag{23}$$

$$= c + dchu$$

由于加工中采用球形刀具,而我们控制的只是刀具球心而非切点,因此需对上述方程进 **行加工方面的修正,其结果如下**:

$$X = au + bshu + \frac{R \cdot dshu}{\sqrt{(a + bchu)^2 + (dshu)^2}}$$

$$Y = c + dchu + \frac{-R \cdot (a + bchu)}{\sqrt{(a + bchu)^2 + (dshu)^2}}$$
(26)

根据此方程编制的加工程序框图可参见图3。

数控编程的难点在于:(1)微机运算功能仅加、减、乘、除、乘方、开方等。对于双曲函数, 我们采用幂级数 展开法计算,其项数由精度要求确定。(2)微机运算时数值超过储存即自动 停车。对此,我们 在程序中采用了ROUND语句,及时去掉精度要求范围之外的尾数。我们 编制的数控程序计算精度为10⁻⁶mm,加工精度根据输入的步长确定,一般取10⁻³mm。



根据上述设计理论并参照张氏电极理论中的紧致性设计要求,我们使用微机和数控机床 已设计并加工出一对电极(如图4)。在准分 子激光器上试用,其放电的均匀性和紧致性都 较好,放电宽度约为10mm。

本工作曾得到中国科技大学马兴孝教授和 北京机床所戴有虎高工的不少指教和帮助,在 此一并致谢。



● 考 文 献

- [1] 赫光生, 雷仕湛。激光器设计基础。上海:上海科学技术出版社, 1979: 186~ 188
- [2] Chang T Y. Rev Scient Instrum, 1973; 44 (4) : 405~407
- 〔3〕 曹洪如。张氏电极的设计计算程序。应用激光联刊,1983;3 (5);61
- [4] 顾骏梁。PC-1500袖珍计算机 (BASIC) 语言实用程序设计。北京:煤炭工业 出版社,1985: 306~316, 391~392
- [5] 北京数控-发那科服务中心编。Fanuc System 6M-Model B 操作说明书(上 册)。22~285

作者简介:徐春生,男,1966年3月出生。现担任牙膏分厂技术科长(代)。主要从事牙 膏生产技术管理、有关散射光学、胶体化学和流变学等方面的理论研究工作。

收稿日期。1989年12月15日。收到修改稿日期。1990年4月10日。

•简 讯•

库列探测器

新泽西州特伦顿Princeton仪器公司推出的INGAS-256NIR型二极管阵列探测器,全部使用标准性能指标(PI)的硬件和软件工作。该探测器由256个提供12.8mm 焦平面视野。在0.8~1.7µm光谱区内有响应度的InGaAs二极管阵列组成。该阵列探测器用热电致 冷在0~-65℃的温度范围之内,以保证最小的暗电荷。

> 译自 L F World, 1990 Jul: 172 邹福清 译 邹声荣 校

用于CO2 和YAG激光器的数字式功率探测器

由Oriel公司生产的手持式30型数字式功率探测器用于高功率激光器的功率级水平 检查 是理想的。这种装置由一台微处理机控制的数字功率计和一个功率计探头组成。探测头可用 干3W 到11kW的功率级水平,一般最小限度的分辨率是探测头量程的0.1%。

译自 L & O, 1990, Aug: 68

张贤义,译 刘建卿 校